

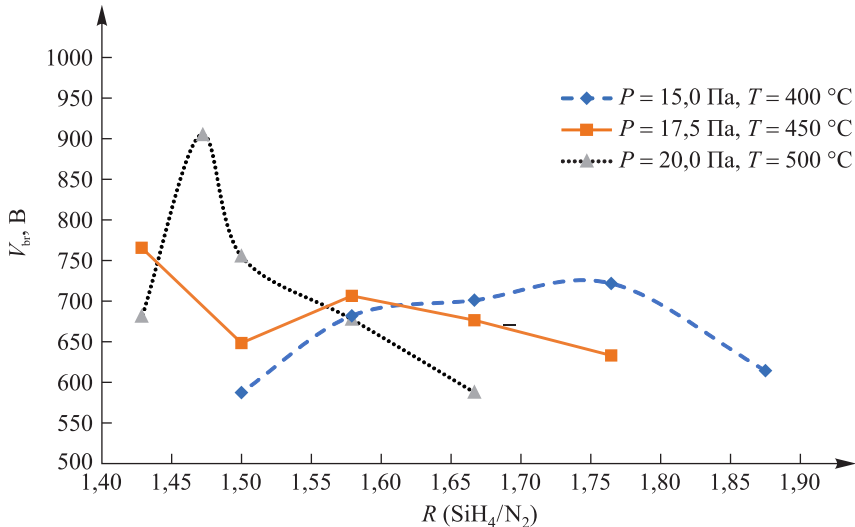


Рис. 5. Зависимость пробивного напряжения для пленок SiN_x от соотношения потоков газов SiH_4/N_2 для трех комбинаций давления и температуры

Fig. 5. Dependence of breakdown voltage for SiN_x films on the gas flow ratio SiH_4/N_2 for three combinations of pressure and temperature